

S05P0006 WD00

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人 松尾 憲一郎 様 あて名 〒 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番26号 今泉コーポラス1階		PCT 国際調査機関の見解書 （法施行規則第40条の2） [PCT規則43の2.1]	
		発送日 （日.月.年） 25. 1. 2005	
出願人又は代理人 の書類記号 SONY-11		今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2004/018939	国際出願日 （日.月.年） 17. 12. 2004	優先日 （日.月.年） 09. 01. 2004	
国際特許分類（IPC）Int. Cl. H01L29/73 H01L 21/331 H01L27/06			
出願人（氏名又は名称） ソニー株式会社			

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 12. 01. 2005			
名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 河 口 雅 英	4 L 8 4 2 1
		電話番号 03-3581-1101 内線 3462	

様式PCT/ISA/237（表紙）（2004年1月）

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____ 語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第Ⅴ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲		有 無
	請求の範囲	1 - 8	
進歩性 (IS)	請求の範囲		有 無
	請求の範囲	1 - 8	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1 - 8	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明

文献1. JP 05-226347 A (日本電気株式会社) 1993. 09. 03, 全文
 文献2. JP 57-132357 A (沖電気工業株式会社) 1982. 08. 16, 全文
 文献3. JP 2000-331953 A (ソニー株式会社) 2000. 11. 30, 全文
 文献4. JP 06-132295 A (株式会社東芝) 1994. 05. 13, 全文
 文献5. JP 03-021054 A (ソニー株式会社) 1991. 01. 29, 全文
 文献6. JP 05-067623 A (日本電気株式会社) 1993. 03. 19, 全文
 文献7. JP 2002-368120 A (ソニー株式会社) 2002. 12. 20, 全文

1. 請求の範囲第1項乃至第8項に係る発明は、文献1第1図、第2図及びその説明箇所に記載されているので、新規性、進歩性を有するということとはできない。

2. 請求の範囲第1項乃至第8項に係る発明は、下記の理由により、進歩性を有するということとはできない。

文献2第2図及びその説明箇所記載の発明において、メインベース領域(22)をシリコンウエハ(21)上に形成した半導体層により構成することは、当該技術分野では周知慣用の技術手段である。

そして、文献2第2図及びその説明箇所記載の発明において、サイドベース領域(27)を不純物イオンの注入により形成することに代えて、ポリシリコン(28)からの不純物の拡散により形成することは、例えば文献3乃至6にみられるような周知技術を適用することにより、当業者が容易になし得たことである。

なお、請求の範囲第1項乃至第8項には記載されていないが、文献1第1図、第

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

2 図及びその説明箇所記載の発明における P-エピタキシャル層 (4)、並びに文献 2 第 2 図及びその説明箇所記載の発明におけるメインベース領域 (22) を SiGe 層で形成することは、例えば文献 7 にみられるように周知慣用の技術手段である。